

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ:	PHYSICAL PHENOMENA
<p>К.А. Панышев, А.С. Ключников</p> <p>Эффект радиационно-индуцированной защелки в 90нм КМОП технологии в зависимости от угла и места падения тяжелой заряженной частиц</p>	<p>K.A. Panyshev, A.S.Klyuchnikov</p> <p>The effect of radiation-induced latchup in 90 nm CMOS technology depending on angle and point of incidence of heavy charged particles</p>
РАЗРАБОТКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ:	DEVELOPMENT AND DESIGNING
<p>Г.Я. Красников, П.В Панасенко, А.В. Волосов</p> <p>Конструктивно-технологические принципы создания СВЧ элементной базы нового поколения на основе объемных технологий современной кремниевой микроэлектроники</p>	<p>G.Ya. Krasnikov, P.V. Panasenko, A.V. Volosov</p> <p>Constructive and technological principles Creations of new generation RF element base of on the basis of volume 3D technologies of modern silicon microelectronics</p>